

## Характеристики полевых транзисторов с р-п переходом и каналом n-типа КП307А, КП307Б, КП307Г, КП307Е, КП307Ж:

Тип полевого транзистора	P МАКС	f МАКС	Предельные значения параметров при T=25°C				Значения параметров при T=25°C									T ОКР
			Uси МАКС	Uзс МАКС	Uзи МАКС	Iс МАКС	Uзи ОТС	g22и	Iз УТ	S	Iс НАЧ	C1и	C12и	Кш		
	мВт	МГц	В	В	В	мА	В	мкСм	нА	мА/В	мА	пФ	пФ	дБ	°С	
КП307А	250	400	27	27	27	25	0,5...3	-	<1	4...9	3...9	<5	<1,5	-	-40...+85	
КП307Б	250	400	27	27	27	25	1...5	-	<1	5...10	1...5	<5	<1,5	-	-40...+85	
КП307Г	250	400	27	27	27	25	1,5...6	<200	<1	6...12	1,5...6	<5	<1,5	-	-40...+85	
КП307Е	250	400	27	27	27	25	<2,5	-	<1	3...8	1,5...5	<5	<1,5	-	-40...+85	
КП307Ж	250	400	27	27	27	25	<7	-	<0,1	>4	3...25	<5	<1,5	-	-40...+85	

### Условные обозначения электрических параметров полевых транзисторов:

- **P МАКС** - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность полевого транзистора.
- **f МАКС** - максимально допустимая рабочая частота полевого транзистора.
- **Uси МАКС** - максимально допустимое напряжение сток-исток.
- **Uзс МАКС** - максимально допустимое напряжение затвор-сток.
- **Uзи МАКС** - максимально допустимое напряжение затвор-исток.
- **Iс МАКС** - максимально допустимый ток стока полевого транзистора.
- **Uзи ОТС** - напряжение отсечки полевого транзистора. Напряжение между затвором и истоком транзистора с р-п переходом или с изолированным затвором, работающего в режиме обеднения, при котором ток стока достигает заданного низкого значения.
- **g22и** - активная составляющая выходной проводимости полевого транзистора в схеме с общим истоком.
- **Iз УТ** - ток утечки затвора. Ток затвора при заданном напряжении между затвором и остальными выводами, замкнутыми между собой.
- **S** - крутизна характеристики полевого транзистора. Отношение изменения тока стока к изменению напряжения на затворе при коротком замыкании по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим истоком.
- **Iс НАЧ** - начальный ток стока. Ток стока при напряжении между затвором и истоком, равном нулю, и при напряжении на стоке, равном или превышающем напряжение насыщения.
- **C1и** - входная ёмкость полевого транзистора. Ёмкость между затвором и истоком при коротком замыкании по переменному току на выходе с общим истоком.
- **C12и** - проходная ёмкость полевого транзистора. Ёмкость между затвором и стоком при коротком замыкании по переменному току на входе в схеме с общим истоком.
- **Кш** - коэффициент шума транзистора.
- **T ОКР** - температура окружающей среды.